淆,我們定義f為考慮短通道效應與不考慮短通道效應(即理想的長通道)下之空乏區電荷比:

$$f = \frac{Q_{sc}'}{Q_{sc}} = \frac{L + L_1}{2L}$$
 (5.17)

所以,只要算出 f 值,便可代入公式(3.41)得到短通道效應之 V_T 。由圖 5-6 的幾何關係,我們有:

$$L_1 = L - 2\Delta \tag{5.18}$$

以及

$$(W_m + r_j)^2 = W_m^2 + (\Delta + r_j)^2$$
 (5.19)

解 (5.19) 式,可得到:

$$\Delta = -r_{i} + \sqrt{r_{i}^{2} + 2r_{i}W_{m}}$$
 (5.20)

將(5.18)式與(5.20)式代入(5.17)式,可得:

$$f = \frac{L - \Delta}{L} = 1 - \frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2W_m}{r_j}} - 1 \right)$$
 (5.21)

且短通道效應之臨界電壓可修改(3.41)式得到:

$$V_{T}(短通道) = \phi_{ms} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}} - \frac{fQ_{sc}}{C_{ox}} + 2\psi_{B}$$
 (5.22)

比較(3.41)式與(5.22)式,可得到短通道效應使得臨界電壓偏離之值 等於: